

DF8L60US

600V 8A

特長

- SMD
- 高耐圧
- trr=25ns

Feature

- SMD
- High Voltage
- trr=25ns

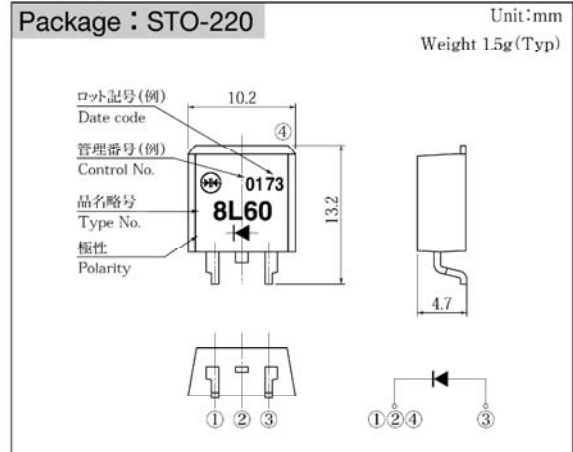
用途

- PFC
- スイッチング電源
- フライホール
- 家電、OA
- FA

Main Use

- PFC(Power Factor Correction)
- Switching Regulator
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation
- Factory Automation

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

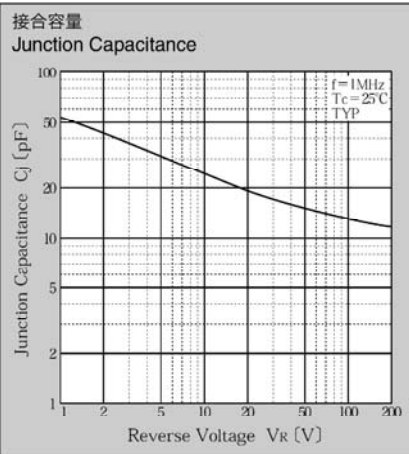
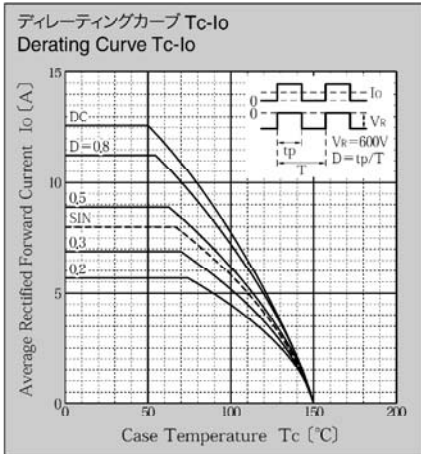
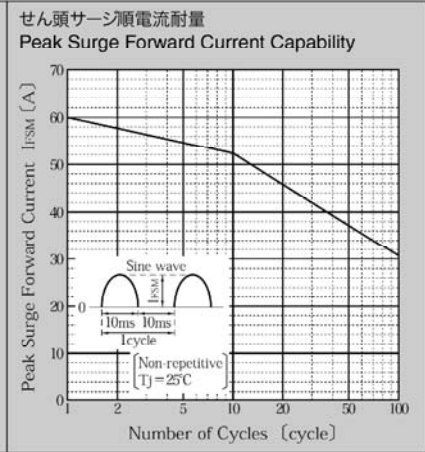
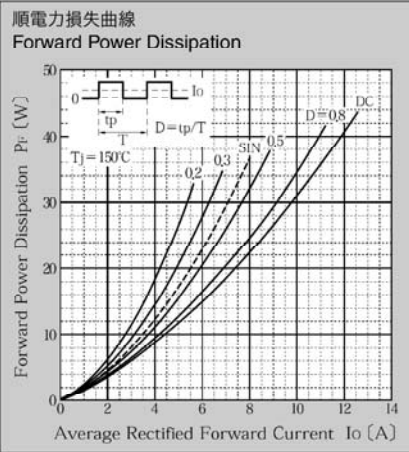
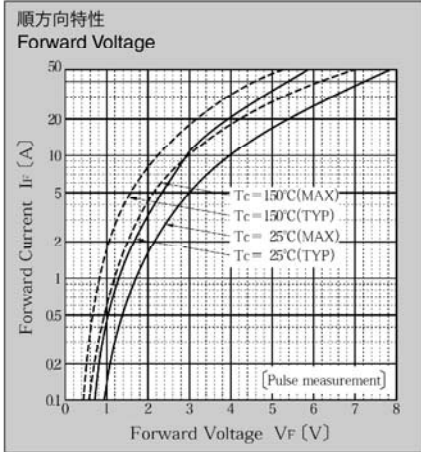
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF8L60US	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 66^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 66^\circ\text{C}$		8	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		60	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	DF8L60US	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 8\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.6	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 600\text{V}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 50	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5\text{A}$, $I_R = 1.0\text{A}$, $0.1I_R$	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$	TYP 24	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typicalは統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.